

1SS187LP

硅外延平面开关二极管芯片 (4 ")

■用途:

*用于高压、高速开关应用

■特征:

*较低的正向压降

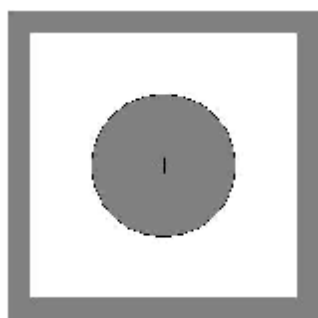
*较低的反向恢复时间

*用于片式封装

*较小的总电容

*有效图形数 78900 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	300 μ m × 300 μ m
压焊区尺寸	φ 130 μ m
芯片厚度	220 ± 10 μ m
金属层	正面: Al (-极) 2.3 ± 0.2 μ m 背面: Au (+极) 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性 (Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	单位
反向电压	V _R	I _R =0.1mA	80		V
正向压降	V _F (1)	I _F =10mA		1.0	V
	V _F (2)	I _F =100mA		1.2	V
反向漏电流	I _R (1)	V _R =20V		25	nA
	I _R (2)	V _R =75V		1	μ A
反向恢复时间	t _{rr}	V _R =6V, I _F =10mA, R _L =75 Ω		4.0	ns